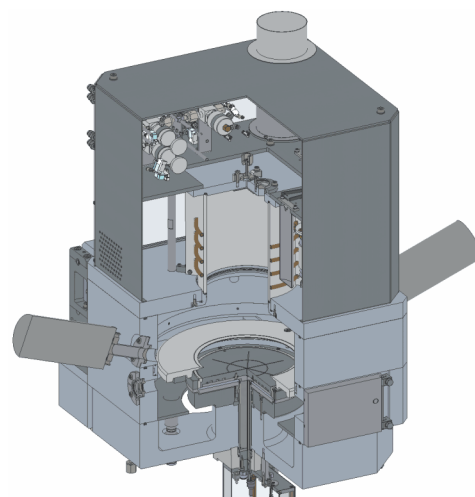
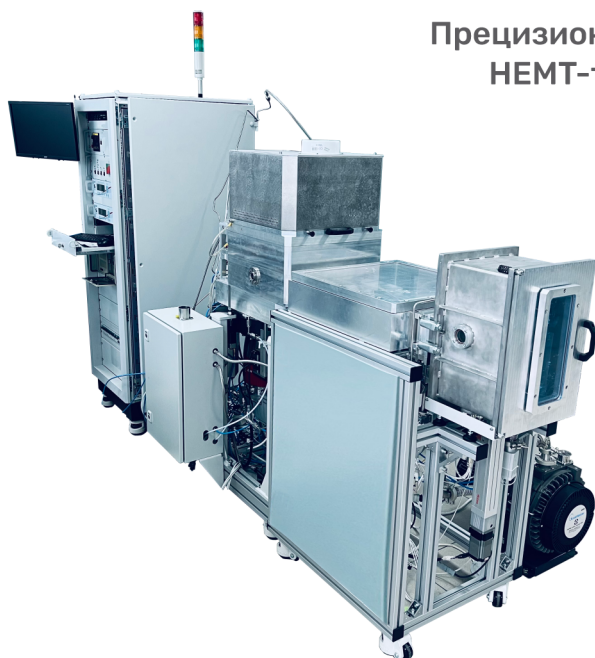


ПЛАЗМА ТМ 200-04

Прецизионное травление GaN / AlGaN (в процессе создания
HEMT-транзисторов), а также травление подзатворного
диэлектрика в КМОП-технологии.



Технические характеристики

- Реактор с ICP источником (индуктивно-связанной плазмы), конструктивно выполненным в виде цилиндрического индуктора;
- Обработка пластин на рабочем столе: Ø 76, 100, 150, 200мм;
- Специальные порты для подключения эллипсометра, для измерения стравленного слоя во время процесса;
- Рабочий стол с гелиевым охлаждением от -20 до +90 °С с механическим прижимом;
- Блок клапанов для попеременной подачи до 3 прекурсоров с временем циклов от 1,5 сек.

